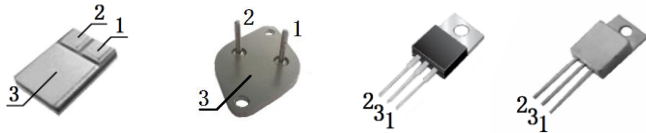


3DD21 型 NPN 硅低频大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值						单位
			A	B	C	D	E	F	
极限值	P_{CM}	$T_C=75^{\circ}C$	10						W
	I_{CM}		0.6						A
	T_{jm}		175						$^{\circ}C$
	T_{stg}		-55~150						$^{\circ}C$
	R_{th}	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.2A$	10						$^{\circ}C/W$
直流参数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=1mA$	≥ 150	≥ 250	≥ 400	≥ 500	≥ 600	≥ 700	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=1mA$	≥ 100	≥ 200	≥ 300	≥ 400	≥ 500	≥ 600	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=0.5mA$	≥ 5.0						V
	I_{CBO}	$V_{CB}=50V$	≤ 0.2						mA
	I_{CEO}	$V_{CE}=50V$	≤ 0.5						mA
	I_{EBO}	$V_{EB}=4V$	≤ 0.2						mA
	V_{BEsat}	$I_C=0.15A$	≤ 1.0						V
	V_{CEsat}	$I_B=0.015A$	≤ 1.0						
	h_{FE}	$V_{CE}=20V$ $I_C=0.15A$	15~180						
外形线说明	 SMD-1 B2-01B(F1) TO-220 TO-257 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极								
替代型号:									